



一、简介

浪拓电子 BS0300N-C 半导体放电管(瞬态浪涌抑制器 TSS), 主要应用于视频信号口过压保护, XDSL 二次侧保护, 节电容小于 70pF。

二、型号命名说明

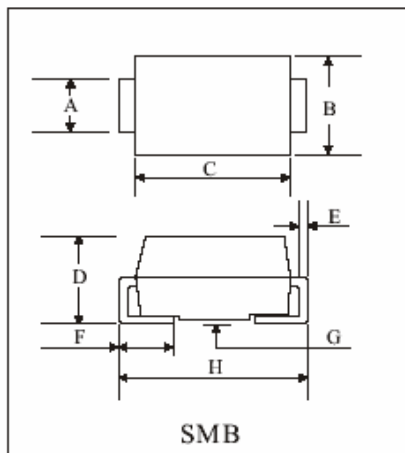
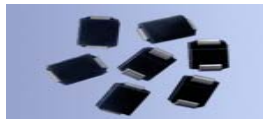
BS	0300	N	C
(1)	(2)	(3)	(4)

- (1) 浪拓电子半导体系列;
- (2) 产品系列: 0060、0250、0300 等;
- (3) 封装形式: SMB ;
- (4) 浪涌承受能力: 100A(10/1000 μ S)。

三、特性

- 节电容小于 80 pF, 可满足信号接口等高速率传输线路的需要;
- 可控硅结构, 开启电压一致性明显优于气体放电管、压敏电阻;
- 纳秒级的反应速度, 使设备对雷电突波、瞬间过电压防护更加安全、可靠;
- 无极性、双向浪涌保护、吸收特性良好;
- 重复性优良, 寿命长, 不会疲劳失效。
- 符合 IEC61000-4-2 规格。


四、外型尺寸



:mm

	A	B	C	D	E	F	G	H
SMB	1.96-2.11	3.30-3.94	4.06-4.57	2.13-2.44	0.152-0.305	0.76-1.52	0.102-0.203	5.21-5.59

五、电气参数 (@T=25℃,RH=45%-75%)

	断态电压		转折电压		通态压降		维持电 流	极间电 容
	VDRM V	IDRM μA	VS V	IS mA	VT V	IT A	IH mA	CO pF
		MAX	TYPE	MAX	MAX		MIN	MAX
BS0300N-C	25	5	40	800	4	2.2	50	80

注：

- 以上参数均在室温 25℃时测得；
- 常规型号极间电容在 1MHz@ DC2V；
- 该产品系列可承受 50A (8/20uS) ,3KV(10/700uS)。

六、可靠性试验项目

试验内容	参考标准	试验条件	试验方法	实验结果
高温反偏试验	MIL-STD-750B METHOD-1026	TA=150℃ BiasV=80%VDRM T=96Hours	在规定温度烤箱中,放电管两极加以规定的偏压,持续指定的时间。	初始检测、最终检测满足各项技术要求。
耐焊接热试验	MIL-STD-750B METHOD-2031	TA=260+5℃/-0℃ T=10Sec	直接放入锡炉中	初始检测、最终检测满足各项技术要求。
可焊性试验	MIL-STD-202E METHOD-208	TA=230℃ T=5Sec	直接放入锡炉中	初始检测、最终检测满足各项技术要求。

七、标识

举例	封装	型号	标识
	SMB	BS0300MS	S03A 0526

 标识说明(Notes): B 03 NC 0526
 (1) (2) (3) (4)

(1)浪拓半导体系列: LT Semiconductor Surge Protector;

(2)产品系列: 0060、0250、0300 等;

(3)封装(Package): SMB;

额定浪涌电流 (10/1000 μs): 100A;

(4)产品的生产日期(Date) 如: 0526 表示 2005 年第 26 周。